



MD 2223 C2 2003.07.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Protecția Proprietății Industriale

(11) **2223** ⁽¹³⁾ **C2**
(51) Int. Cl.⁷: H 01 L 27/22

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

(21) Nr. depozit: a 2001 0363 (22) Data depozit: 2001.11.07	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2003.07.31, BOPI nr. 7/2003
(71) Solicitant: DOROGAN Valerian, MD (72) Inventatori: DOROGAN Valerian, MD; VIERU Tatiana, MD; SECRIERU Vitalie, MD (73) Titular: DOROGAN Valerian, MD	

(54) **Senzor fotoelectromagnetic**

(57) **Rezumat:**

1
Invenția se referă la tehnica cu semiconductori și
poate fi utilizată pentru detectarea câmpurilor
magnetice și electromagnetice în sistemele electro-
nice și optoelectronice moderne.

Senzorul fotoelectromagnetic include un strat
activ semiconductor de tip $n^0(p^0)$ depus pe un
substrat semiconductor semiizolator, pe stratul activ
fiind depuse contacte ohmice de alimentare și

2
contacte ohmice pentru înregistrarea tensiunii Hall.
5 Pe stratul activ $n^0(p^0)$ este depus local un strat
semiconductor $p^+(n^+)$, pe care este format un
contact ohmic, cu posibilitatea iluminării stratului
 $p^+(n^+)$.

Revendicări: 1

Figuri: 1

10

MD 2223 C2 2003.07.31

Descriere:

Invenția se referă la tehnica cu semiconductori și poate fi utilizată pentru detectarea câmpurilor magnetice și electromagnetice în sistemele electronice și optoelectronice moderne.

În prezent este cunoscută o serie de senzori de câmp magnetic, printre care:

- 5 – magnetorezistoare care își schimbă rezistența interioară numai sub acțiunea câmpului magnetic, deci, semnalul de ieșire poate fi modulat numai de intensitatea câmpului magnetic și de tensiunea de polarizare, de asemenea acest senzor are sensibilitate redusă [1];
- senzori de câmp magnetic pe bază de magnetodiode, care au aceleași neajunsuri ca și primii, sensibilitatea fiind la fel insuficientă [2];
- 10 – senzori de câmp magnetic de tip magnetotranzistor bipolar, care are sensibilitate suficientă, dezavantajul fiind acela că își schimbă conductibilitatea numai sub acțiunea câmpului magnetic și nu reacționează la alți factori exteriori cum ar fi radiația optică [3].

În calitate de cea mai apropiată soluție a fost luat senzorul ce funcționează pe baza efectului Hall [4]. Senzorul de tip Hall include stratul activ $n^0(p^0)$ format pe un substrat semizolator și are două

15 contacte ohmice de alimentare și două contacte ohmice de înregistrare a tensiunii Hall. Dezavantajul acestui senzor constă în lipsa posibilității modulării semnalului de ieșire cu ajutorul semnalelor optice, deci, semnalul de ieșire poate fi modulat numai cu ajutorul tensiunii de alimentare sau a câmpului magnetic.

Problema pe care o rezolvă invenția este crearea unui senzor multifuncțional, ce poate detecta

20 semnalele optice, electrice și magnetice. Conform invenției, problema stipulată se soluționează prin aceea că senzorul fotoelectromagnetic include un strat activ semiconductor de tip $n^0(p^0)$ depus pe un substrat semiconductor semizolator, pe stratul activ fiind depuse contacte ohmice de alimentare și contacte ohmice pentru înregistrarea

25 tensiunii Hall. Pe stratul activ $n^0(p^0)$ este depus local un strat semiconductor $p^+(n^+)$, pe care este format un contact ohmic, cu posibilitatea iluminării stratului $p^+(n^+)$.

În așa mod, tensiunea Hall depinde nu numai de intensitatea câmpului magnetic și de valoarea de

alimentare, dar și de următorii factori:

- polaritatea și valoarea tensiunii de alimentare a joncțiunii $p-n$;
- intensitatea fluxului optic incident;
- 30 – lungimea de undă a fluxului incident;
- frecvența semnalului optic incident.

Rezultatul constă în modularea semnalului de ieșire cu ajutorul semnalelor optice, câmpurilor

35 electrice și magnetice. Invenția se explică prin figură, care reprezintă structura senzorului electromagnetic. Ea constă din substrat semizolator 1, strat activ 2 de tip $n^0(p^0)$, strat 3 de tip $p^+(n^+)$ format local, contacte de alimentare 4 și 5, contacte 6, 7 pe care se înregistrează tensiunea Hall și cu contact 8 cu ajutorul căruia se aplică tensiunea de polarizare a joncțiunii $p-n$. Stratul 9 reprezintă stratul de sarcină spațială a joncțiunii $p-n$.

40 La aplicarea tensiunii de alimentare la contactele ohmice 4 și 5 prin stratul activ 2 curge curentul de lucru. În prezența unui câmp magnetic pe contactele ohmice 6 și 7 apare tensiunea Hall, valoarea căreia depinde de tensiunea aplicată și de intensitatea câmpului magnetic. Joncțiunea $p-n$ formată local (straturile 2 și 3) lărgeste posibilitățile funcționale ale senzorului. La polarizarea directă a joncțiunii curentul de lucru a senzorului se mărește cu valoarea curentului injectat prin joncțiune. La polarizarea

45 inversă curentul de lucru se micșorează, deoarece stratul de sarcină spațială 9 se extinde în stratul $n^0(p^0)$, blocând scurgerea curentului de lucru prin stratul activ 2. În așa mod, tensiunea Hall, înregistrată pe contactele ohmice 6 și 7, poate fi modulată cu ajutorul semnalelor electrice aplicate la contactul 8.

Deoarece joncțiunea $p-n$ are fotosensibilitate selectivă (lucrează ca o fotodiodă selectivă), tensiunea Hall se modulează și cu ajutorul semnalelor optice incidente pe stratul $p^+(n^+)$ 3. În acest caz, curentul de lucru se mărește cu valoarea fotocurentului joncțiunii $p-n$, care depinde de intensitatea fluxului

50 incident, frecvența fluxului incident, lungimea de undă a fotonilor incidenți. Un alt avantaj major al senzorului fotoelectromagnetic, care îl transformă într-un dispozitiv multifuncțional, este că, în funcție de necesități, el poate funcționa separat ca senzor Hall obișnuit, fotodiodă, magnetorezistor, magneto-

diodă.

Exemplu de realizare a invenției

55 Pe un substrat semizolator 1 GaAs, prin metoda epitaxiei din fază lichidă, se formează un strat 2 n^0 GaAs cu grosime de 2-4 μm și concentrația purtătorilor de sarcină $n^0=10^{15} \text{ cm}^{-3}$, un strat 3 p^+ $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ de aceeași grosime cu compoziția în intervalul $0,3 < x < 0,8$ și concentrația purtătorilor de sarcină $p^+ = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. Utilizând metoda de fotolitografie, stratul 3 se corodează de pe suprafața stratului 2 cu excepția unei regiuni locale, iar contactul 8 se formează periferic pe stratul p^+ . Contactele

MD 2223 C2 2003.07.31

4

ohmice 4-8 se formează folosind metoda depunerii termice în vid a Ni. Dimensiunile stratului activ sunt 2 x 10 mm, dimensiunile stratului 3 sunt 2 x 2 mm. Contactele ohmice 5 și 4 au dimensiunile 2 x 0,5 mm și grosimea 0,1 mm. Contactele 7, 6 au aceeași grosime și dimensiunile 0,5 x 0,5 mm și sunt plasate la o distanță de 3,0 mm de la contactul 5. Fotosensibilitatea joncțiunii $p-n$ este determinată de compoziția stratului $Al_xGa_{1-x}As$ (valoarea lui x).

10 (57) Revendicare:

Senzor fotoelectromagnetic, care include un strat activ semiconductor de tip $n^0(p^0)$ depus pe un substrat semiconductor semiizolator, pe stratul activ fiind depuse contacte ohmice de alimentare și contacte ohmice pentru înregistrarea tensiunii Hall, **caracterizat prin aceea că** pe stratul activ $n^0(p^0)$ este depus local un strat semiconductor $p^+(n^+)$, pe care este format un contact ohmic, cu posibilitatea iluminării stratului $p^+(n^+)$.

(56) Referințe bibliografice:

1. Егизарян Г. Ф., Стафеев В. И., Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение. «Радио и связь», 1987, с. 55
2. Марченко А. Н., Свечников С. В., Смовж А. К., Полупроводниковые сенсоры, потенциометрические элементы. М., «Радио и связь», 1988, с. 192
3. Хомерики О. К. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля. М., «Энергоатомиздат», 1986, с. 136
4. Викулин И. М., Викулина Л. Ф., Стафеев В. И., Гальваномангнитные приборы. М., «Радио и связь», 1983, с. 104

Șef Secție:

NEKLIUDOVA Natalia

Examinator:

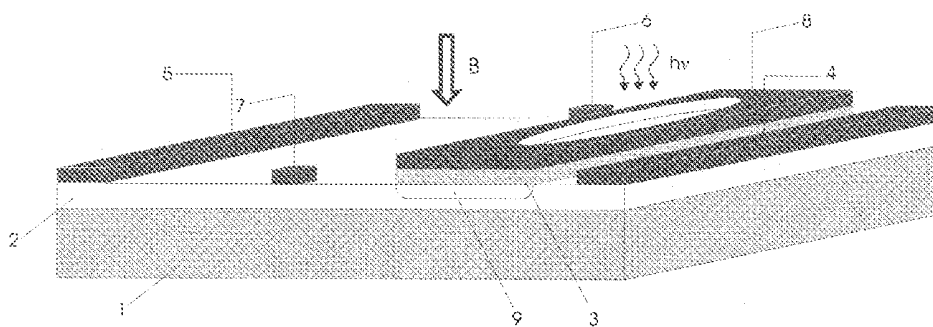
COJOCARU Ala

Redactor:

ANDRIUȚĂ Victoria

MD 2223 C2 2003.07.31

5



RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2001 0363		
(22) Data depozit: 2001.11.07		
Prioritatea invocată : (51) ⁷ : H01L 27/22 Alți indici de clasificare: (54) Titlul : Senzor fotoelectromagnetic (71) Solicitantul : DOROGAN Valerian, MD Termeni caracteristici : a) limba română: senzor, Hall, fotoelectromagnetic b) limba engleză: sensor, Hall, photoelectromagnetical		
I. Minimul de documente consultate (sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl.- 7)		
Int. Cl. ⁷ H01L 27/22		
II. Literatura tehnico-științifică consultată adăugător la minim de documentație (autori, titluri, editura, țara și data publicării)		
1. Егизарян Г. Ф., Стафеев В. И.. Магнитодиоды б магнитотранзисторы и их применение. «Радио и связь», 1987, с. 55ю 2. Марченко А. Н., Свечников С. В., Смовж А. К.. Полупроводниковые сенсоры потенциометрические элементы. М., «Радио и связь», 1988, с. 192. 3. Хомерики О. К. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля. М., «Энергоатомиздат», 1986, с. 136. 4. Викулин И. М., Викулина Л. Ф., Стафеев В. И., Гальваномагнитные приборы. М., «Радио и связь», 1983, с. 104.		
III. Baze de date electronice consultate (denumirea BD și termen de documentare)		
MD, perioada 1994-2001 EA, perioada 1996- 2001 BD Espacenet SU, perioada 1984-1994		
IV. Documente considerate ca relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	1. Егизарян Г. Ф., Стафеев В. И.. Магнитодиоды б магнитотранзисторы и их применение. «Радио и связь», 1987, с. 55ю	1
A	2. Марченко А. Н., Свечников С. В., Смовж А. К.. Полупроводниковые сенсоры потенциометрические элементы. М., «Радио и связь», 1988, с. 192.	1
A	3. Хомерики О. К. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля. М., «Энергоатомиздат», 1986, с. 136.	1

A	4. Викулин И. М., Викулина Л. Ф., Стафеев В. И., Гальваномагнитные приборы. М., «Радио и связь», 1983, с. 104.	1
A	5. US5627398	1
A	6. US5578814	1
☐ Documentele următoare sunt indicate în rubrica IV		☐ Informația referitoare la brevete paralele se anexează
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data depozit, dar după data priorității invocate
A - document care definește stadiul anterior general		T - document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția
E - document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta data		X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat de unul singur
L - document care poate pune în discuție data priorității invocate sau poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)		Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă divulgare		& - document care face parte din aceeași familie de documente
Data finalizării documentării		4/04/03
Examinatorul		Cojocar Alina